
	<p><b>SI4388DY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4388DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 10.7A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4388DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 798200 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4388DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 10.7A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	798200 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 10.7A,
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.3W, 3.5W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.7A, 11.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	946pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI4388
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI4388DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4388DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4388DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4388DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4390DY</b> VIS SI4390DY VIS</p>	 <p><b>SI4386DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4388DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 10.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4388DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10.7A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4388DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4386DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4390DY-T1</b> VISHAY SI4390DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4390DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.5A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4362DY-T1-E3	SI4362DY-T1-E3.	SI4364DY	D SI4364DY-T1	SI4364DY-T1-E3
SI4366DY-T1-E3	SI4368DY	D SI4368DY-T1-E3	SI4368DY-T1-E3	SI4370DY-T1-E3
SI4376DY-T1-E3	SI4378DY-T1	SI4378DY-T1-E3	SI4378DY-T1-E3	SI4382DY-T1-E3
D SI4384DY	SI4384DY-T1-E3	SI4384DY-T1-E3	SI4384DY-T1-E3..	SI4386DY
SI4386DY-T1-E3	SI4386DY-T1-E3	SI4386DY-T1-GE3	SI4386DY-T1-GE3	SI4388DY
SI4388DY-T1-GE3	SI4390DY	D SI4390DY-T1	SI4390DY-T1-E3	SI4390DY-T1-E3
SI4390DY-T1-E3	D SI4392ADY	SI4392ADY-T1-E3	SI4392DY	SI4392DY-T1-E3
SI4392DY-T1-E3.	SI4392DY-T1-E3..	SI4394DY	SI4394DY-T1-E3	SI4396DY
SI4396DY-T1-E3	SI4396DY-T1-E3	SI4398DY-T1-E3	D SI4398DY-T1-E3	SI4401BDY-T1-E3
SI4401BDY-T1-E3	SI4401BDY-T1-E3.	SI4401BDY-T1-GE3	SI4401BDY-T1-GE3	SI4401DDY

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited